MBSK12S THRU MBSK110S

RoHS COMPLIANT

肖特基桥式整流器 Schottky Bridge Rectifier

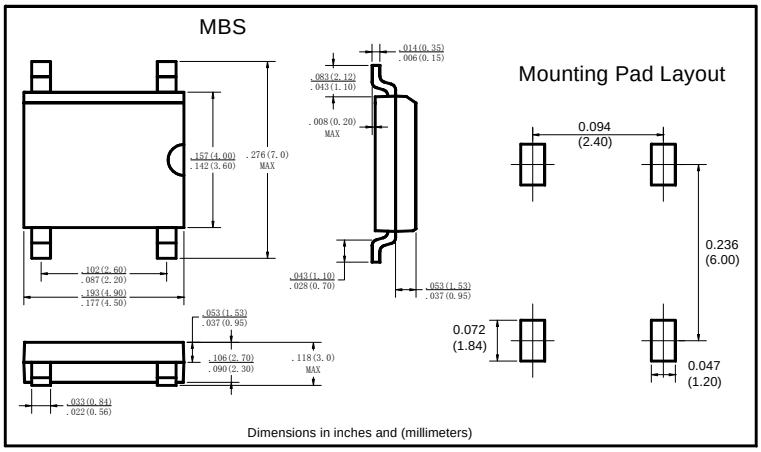
■特征 Features

- I_o 1.0A
- V_{RRM} 20V~100V
- 肖特基芯片
  Schottky chip
- 耐正向浪涌电流能力高
  High surge forward current capability
- 低正向电压
  Low VF

■用途 Applications

- 作一般电源单相桥式整流用
  General purpose 1 phase Bridge rectifier applications

■外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



■极限值（绝对最大额定值）
Limiting Values（Absolute Maximum Rating）

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions		MBSK 12S	14S	16S	18S	110S
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	V			20	40	60	80	100
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	I_O	A	60Hz正弦波，电阻负载，Ta=25℃ 60Hz sine wave, R-load, Ta=25℃	安装在氧化铝基板上 On alumina substrate	1.0				
				安装在玻璃-环氧基板上 On glass-epoxi substrate	0.8				
正向（不重复）浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	I_{FSM}	A	60H_Z正弦波，一个周期，T_j=25℃ 60H_Z sine wave, 1 cycle, T_j=25℃		40				
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	I^2t	A^2S	1ms≤t<8.3ms Tj=25℃，单个二极管 1ms≤t<8.3ms Tj=25℃，Rating of per diode		6.6				
存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	℃			-55 ~+150				
结温 Junction Temperature	T_j	℃			-55 ~+150				

■电特性 （Ta=25℃ 除非另有规定）
Electrical Characteristics（T_a=25℃ Unless otherwise specified）

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition	最大值 Max		
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	V_{FM}	V	I_{FM}=0.5A，脉冲测试，单个二极管的额定值I_{FM}=0.5A, Pulse measurement, Rating of per diode	0.55	0.65	0.75
反向峰值电流 Peak Reverse Current	I_{RRM}	μA	V_{RM}=V_{RRM} ,脉冲测试，单个二极管的额定值 V_{RM}=V_{RRM} , Pulse measurement, Rating of per diode	0.5		
热阻 Thermal Resistance	$R_{\theta J-A}$	℃/W	结和环境之间，安装在氧化铝基板上 Between junction and ambient, On alumina substrate	76		
			结和环境之间，安装在玻璃-环氧基板上 Between junction and ambient, On glass-epoxi substrate	134		
	$R_{\theta J-L}$		结和引线之间 Between junction and lead	20		

■特性曲线（典型） Characteristics(Typical)

图1：Io-Ta曲线
FIG1:Io-Ta Curve

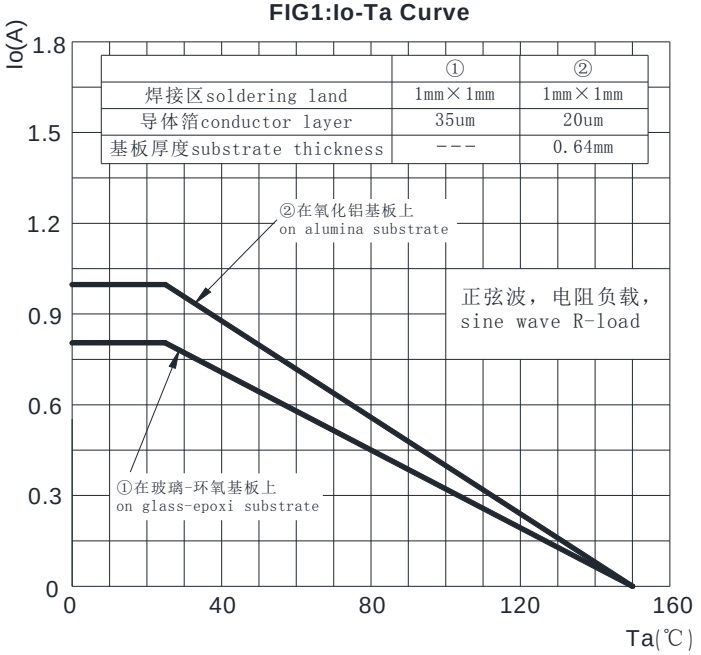


图2：耐正向浪涌电流曲线
FIG2:Surge Forward Current Capadility

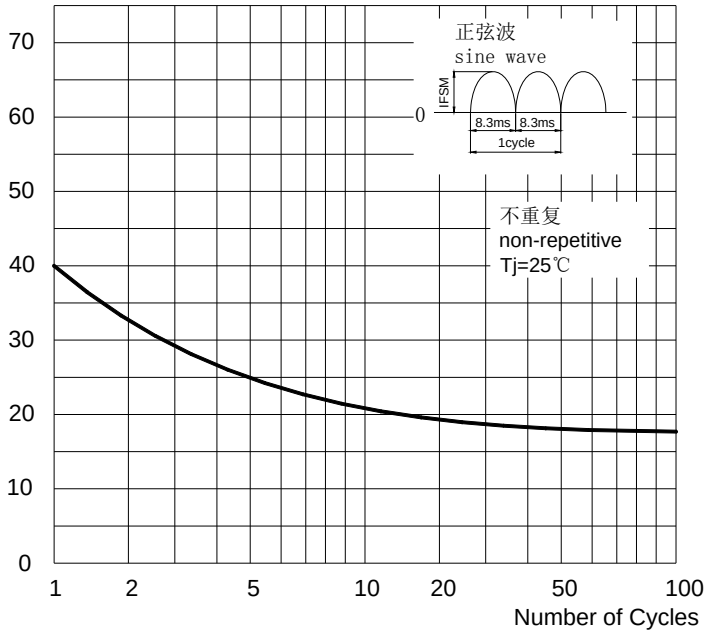


图3：正向电压曲线
FIG3: Forward Voltage

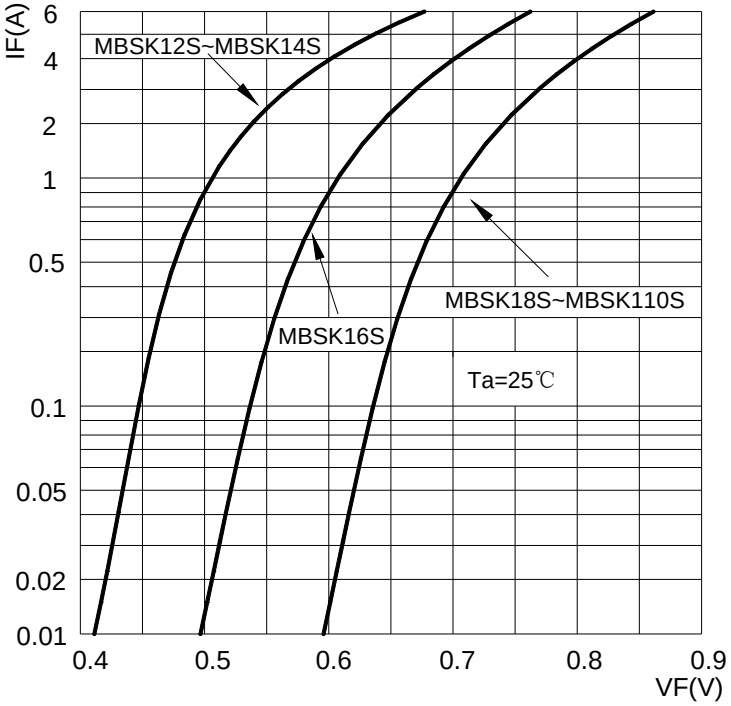


图4：反向电流曲线
FIG4:Typical Reverse Characteristics

